







	<h2>SI3474DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3474DV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SI3474DV-T1-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SI3474DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 43750 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3474DV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	43750 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	3.6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	126 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	196pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3474DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3474DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3474DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3474DV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3475DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3475DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 0.95A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3473DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3473DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3473DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3474DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.8A TSOP-6</p>	 <p><b>SI3473DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3475DV</b> VISHAY VISHAY SOT-163</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ SI3465DV-T1-E3	↔ SI3465DV-T1-E3	⇒ SI3465DV-T1-GE3	D SI3465DV-T1-GE3	⇒ SI3467DV
⊣ SI3467DV-T1-E3	⊗ SI3467DV-T1-E3	D SI3467DV-T1-GE3	⇒ SI3467DV-T1-GE3	⇒ SI3469DV-T1
⊗ SI3469DV-T1-E3	⊣ SI3469DV-T1-E3	⊗ SI3469DV-T1-GE3	↔ SI3469DV-T1-GE3	⇒ SI3471DV-T1-E3
D SI3473CDV-T1-E3	⊗ SI3473CDV-T1-E3	⊣ SI3473CDV-T1-GE3	⊗ SI3473CDV-T1-GE3	⇒ SI3473DDV-T1-GE3
⇒ SI3473DV-T1-E3	↔ SI3473DV-T1-E3	⊗ SI3473DV-T1-GE3	⊣ SI3473DV-T1-GE3	⇒ SI3474DV-T1-GE3
↔ SI3475DV-T1-E3	⇒ SI3475DV-T1-E3	D SI3475DV-T1-GE3	⊗ SI3475DV-T1-GE3	⊣ SI3476DV-T1-E3
⊗ SI3476DV-T1-GE3	D SI3476DV-T1-GE3	⇒ SI3477DV-T1-E3	↔ SI3477DV-T1-GE3	⇒ SI3477DV-T1-GE3
⊣ SI3481DV-T1-E3	⊗ SI3481DV-T1-E3	↔ SI3481DV-T1-GE3	⇒ SI3481DV-T1-GE3	⇒ SI3483CDV-T1-E3
⊗ SI3483CDV-T1-E3	⊣ SI3483CDV-T1-GE3	⊗ SI3483CDV-T1-GE3	D SI3483DV-T1-E3	⇒ SI3483DV-T1-E3
↔ SI3483DV-T1-GE3	⊗ SI3483DV-T1-GE3	⊣ SI3493BDV-T1-E3	⊗ SI3493BDV-T1-E3	⇒ SI3493BDV-T1-E3-S

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited